Chapitre 9 - Propriétés physiques

EXERCICE 9-10

Le carbure de silicium SiC est une céramique semi-conductrice dont voici la valeur de quelques propriétés physiques :

 $\begin{array}{ll} \succ & \text{Conductivit\'e \'electrique intrins\`eque}: & \pmb{\sigma_i} = 8 \text{ S/m \`a 20 °C} \\ \blacktriangleright & \text{Mobilit\'e des \'electrons}: & \pmb{\mu_e} = 0,04 \text{ m}^2/\text{V.s} \\ \blacktriangleright & \text{Mobilit\'e des trous}: & \pmb{\mu_t} = 0,02 \text{ m}^2/\text{V.s} \\ \blacktriangleright & \text{Largeur de la bande interdite}: & E_g = 2,9 \text{ eV} \end{array}$

- a) Quel est le type de liaison prédominante dans le SiC?
- b) Quel est le nombre *n* de porteurs de charges électriques par unité de volume à 20 °C?
- c) À quelle température (en °C) faut-il chauffer le carbure de silicium pour que sa conductivité électrique soit égale à 1000 S/m ?
- d) Si on ajoute de l'azote comme dopant au SiC, quel type de semi-conducteur extrinsèque obtient-on ?
- e) Quelle quantité d'azote (en atome/m³) faut-il ajouter au SiC pour que sa conductivité soit égale à 1000 S/m à 20 °C ? On supposera que tous les atomes d'azote contribuent à la conductivité extrinsèque.